









	<h2 style="color: red;">IPD60R600P7SAUMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD60R600P7SAUMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 6A TO252-3
Datenblätter:	 IPD60R600P7SAUMA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPD60R600P7SAUMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 6A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 80µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	CoolMOS™ P7
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 1.7A, 10V
Verlustleistung (max)	30W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	IPD60R600P7SAUMA1-ND
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	363pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 6A (Tc) 30W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

IPD60R600P7SAUMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD60R600P7SAUMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD60R600P7SAUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD60R600P7SAUMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  IPD60R650CEATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V TO-252-3	 IPD60R600P6 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 7.3A TO252	 IPD60R650CEBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 7A TO252	 IPD60R650CEAUMA1 Infineon Technologies CONSUMER
 IPD60R600P6ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 7.3A TO252	 IPD60R600P7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 6A TO252-3	 IPD60R750E6ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 5.7A TO252	 IPD60R750E6 Infineon Technologies IPD60R750E6 Infineon Technologies

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD60R600P7SAUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD60R600P7SAUMA1 Datenblatt	IPD60R600P7SAUMA1-Datenblätter	IPD60R600P7SAUMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD60R600P7SAUMA1
IPD60R600P7SAUMA1 Electronic	IPD60R600P7SAUMA1-Komponenten	IPD60R600P7SAUMA1-Verteiler	IPD60R600P7SAUMA1-Bild	IPD60R600P7SAUMA1-Teil
IPD60R600P7SAUMA1 Preis	IPD60R600P7SAUMA1 Hersteller	IPD60R600P7SAUMA1 Bild	IPD60R600P7SAUMA1 Aktie	IPD60R600P7SAUMA1 Inventar
IPD60R600P7SAUMA1 Neu	IPD60R600P7SAUMA1 Original	IPD60R600P7SAUMA1 garantiert	IPD60R600P7SAUMA1 RFQ	IPD60R600P7SAUMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited